

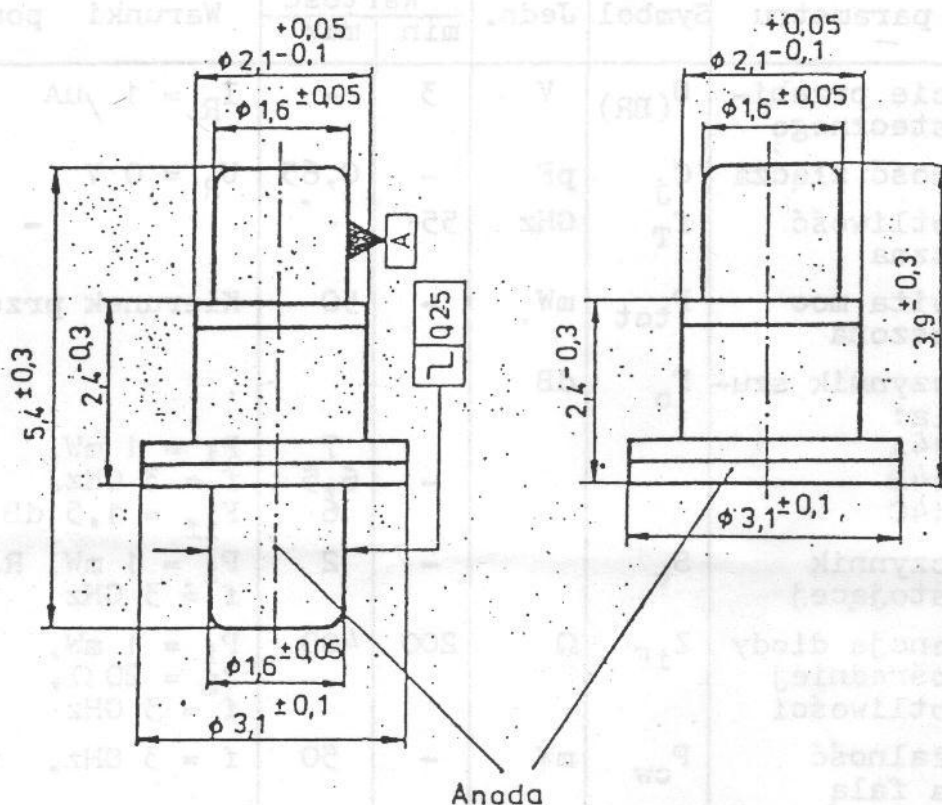
## BADP 14

### Dioda Schottky'ego

Informacja: prof. dr hab. Inż. Jerzy Klamka

tel. (0-22) 47 21 61

fax (0-22) 47 06 31



Obudowa diody Schottky'ego BADP 14

Dioda BADP 14 jest krzemową diodą z barierą powierzchniową w obudowie ceramiczno-metalowej OC4 lub OC4p. Przeznaczona jest do pracy w mieszaczach mikrofalowych w paśmie 2 - 4 GHz. Jej podtypami są diody: BADP 14A, BADP 14B, BADP 14C.

#### DOPUSZCZALNE PARAMETRY EKSPLOATACYJNE

Prąd wsteczny

$I_R$  1  $\mu A$

Prąd w kierunku przewodzenia

$I_F$  60 mA

Temperatura pracy

$t_{amb}$  -55 + 100 °C

Temperatura przechowywania  
Całkowita moc rozproszona  
Temperatura złącza

$t_{stg}$  -55 + 100 °C  
 $P_{tot}$  50 mW  
 $t_j$  150 °C

# ELEKTRYCZNE PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE

| Nazwa parametru                                                   | Symbol     | Jedn.    | Wartość |               | Warunki pomiaru                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------|---------------|----------------------------------------------------|
|                                                                   |            |          | min.    | max           |                                                    |
| Napięcie przebi-<br>cia wstecznego                                | $U_{(BR)}$ | V        | 3       | -             | $I_R = 1 \mu A$                                    |
| Pojemność złącza                                                  | $C_j$      | pF       | -       | 0,65          | $U_R = 0 V$                                        |
| Częstotliwość<br>graniczna                                        | $f_T$      | GHz      | 55      | -             | -                                                  |
| Całkowita moc<br>rozproszona                                      | $P_{tot}$  | mW       | -       | 50            | Kierunek przewodzenia                              |
| Współczynnik szu-<br>mów dla:<br>BADP 14A<br>BADP 14B<br>BADP 14C | $F_o$      | dB       | -       | 7<br>6,5<br>6 | $P_i = 1 mW,$<br>$f = 3 GHz,$<br>$F_{if} = 1,5 dB$ |
| Współczynnik<br>fali stojącej                                     | $S_v$      |          | -       | 2             | $P_i = 1 mW, R_L = 20 \Omega,$<br>$f = 3 GHz$      |
| Impedancja diody<br>dla pośredniej<br>częstotliwości              | $Z_{iF}$   | $\Omega$ | 200     | 400           | $P_i = 1 mW,$<br>$R_L = 20 \Omega,$<br>$f = 3 GHz$ |
| Obciążalność<br>mocowa falą<br>ciągłą                             | $P_{cw}$   | mW       | -       | 50            | $f = 3 GHz, t = 5 min$                             |
| Pojemność<br>rozproszona                                          | $C_p$      | pF       | -       | 0,25          | $f = 1 MHz$                                        |
| Całkowita szere-<br>gowa indukcyjność<br>zastępcza                | $L_s$      | nH       | -       | 0,8           | $f = 3 GHz$                                        |
| Maksymalna ener-<br>gia pojedyncze-<br>go impulsu                 | $W_B$      | erg      | -       | 5             | $\tau = 2,5 ns$                                    |



INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

Al.Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Tel. (0-22) 47 21 61, 43 49 83 • Fax (0-22) 47 06 31